

МОДУЛИ ТИРИСТОРНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ

МТТ12/3-500, МДТ12/3-500, МТД12/3-500, МТТ12/4-500, МТТ12/5-500,

МТТ12/3-630, МДТ12/3-630, МТД12/3-630, МТТ12/4-630, МТТ12/5-630,

МТТ12/3-800, МДТ12/3-800, МТД12/3-800, МТТ12/4-800, МТТ12/5-800

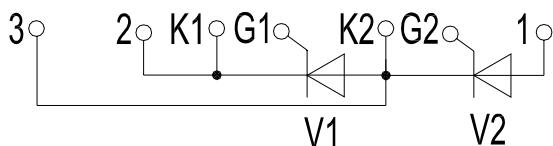
Модули тиристорные и комбинированные (в пластмассовом корпусе с беспотенциальным основанием) состоят из силовых полупроводниковых элементов: тиристоров, диодов, собранных по схемам, указанным ниже.

Модули предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока различных силовых электротехнических установок при частоте до 500 Гц.

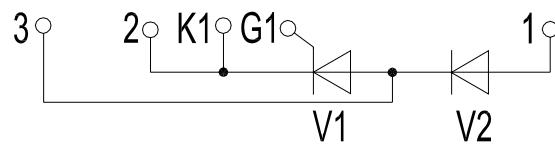
Вид климатического исполнения и категория размещения У2.

Схемы внутреннего соединения полупроводниковых элементов модулей

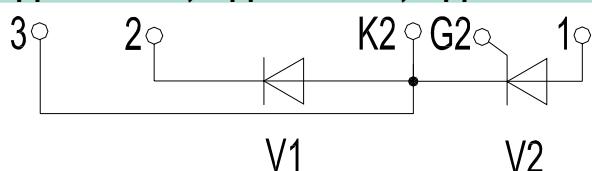
МТТ12/3-500, МТТ12/3-630, МТТ12/3-800



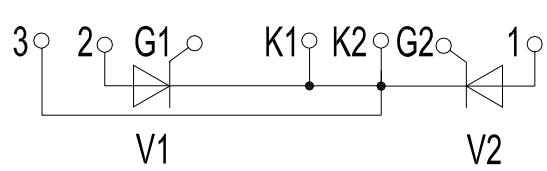
МТД12/3-500, МТД12/3-630, МТД12/3-800



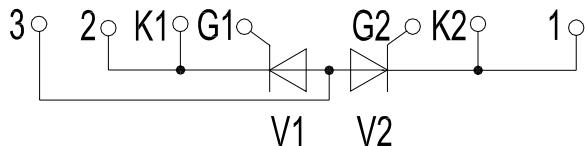
МДТ12/3-500, МДТ12/3-630, МДТ12/3-800



МТТ12/4-500, МТТ12/4-630, МТТ12/4-800



МТТ12/5-500, МТТ12/5-630, МТТ12/5-800



V1 - первый полупроводниковый элемент модуля

V2 - второй полупроводниковый элемент модуля

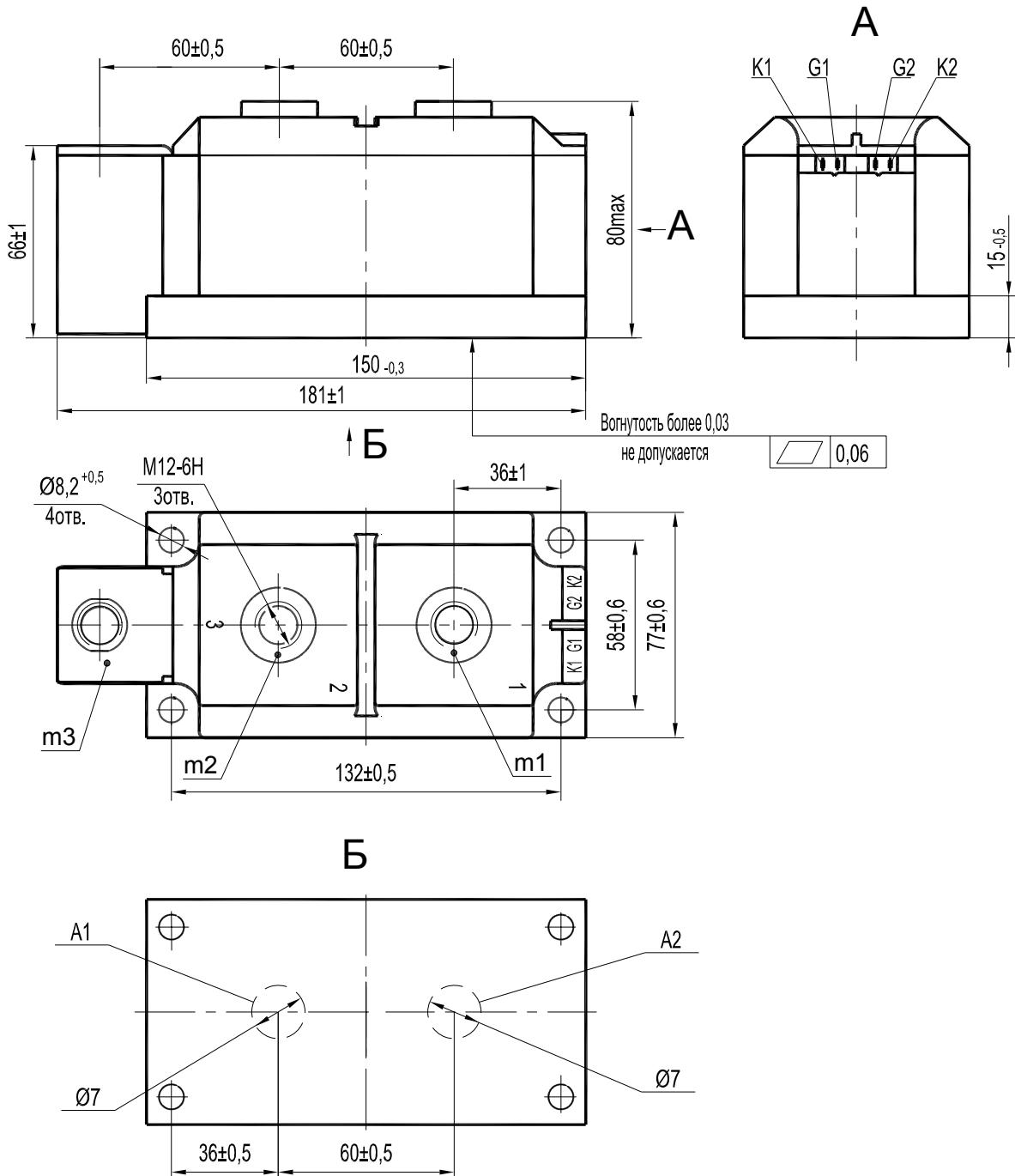
Крутящий момент, прикладываемый к крепежному винту M8 при монтаже модуля на охладитель ($8,0 \pm 0,8$) Нм.

Крутящий момент, прикладываемый к винту (болту) при подключении основных выводов модулей ($12,0 \pm 1,2$) Нм. Растягивающая сила для управляющих выводов ($20,0 \pm 2,0$) Н.

Пример заказа 50 штук модулей типа МТД12/3-800 12 класса с критической скоростью нарастания напряжения в закрытом состоянии тиристорного элемента по 7-й группе, с временем выключения по группе K2, с указанием фактического значения импульсного напряжения в открытом состоянии, импульсного прямого напряжения (например, 1,38/1,3 В):

МТД12/3-800-12-7K2-1,38/1,3 ТУ У 32.1-30077685-029:2007 50 шт.

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
**МТТ12/3-500, МТД12/3-500, МДТ12/3-500, МТТ12/4-500, МТТ12/5-500,
 МТТ12/3-630, МТД12/3-630, МДТ12/3-630, МТТ12/4-630, МТТ12/5-630,
 МТТ12/3-800, МТД12/3-800, МДТ12/3-800, МТТ12/4-800, МТТ12/5-800**



A1, A2 - области контроля температуры корпуса модуля;
 m1, m2, m3 - контрольные точки измерения импульсного напряжения в открытом состоянии, импульсного прямого напряжения;

1, 2, 3 - основные выводы;

G1, K1, G2, K2 - управляющие выводы

Масса не более 3,36 кг

Параметры закрытого состояния, обратные параметры

Параметр		Значение параметра модуля		Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	MTT12/3-500 МТД12/3-500 МДТ12/3-500 MTT12/4-500 MTT12/5-500	MTT12/3-630 МТД12/3-630 МДТ12/3-630 MTT12/4-630 MTT12/5-630	
U_{DRM} U_{RRM}	Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов: 10 - 12 - 14 - 16 1600 1600 18 1800 1800 20 2000 - 22 2200 - 24 2400 - 26 2600 -		1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600	$T_{jm} = 125^{\circ}\text{C}$ Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный длительностью не более 10 мс, управляющий вывод разомкнут
U_{DSM} U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов: 10 - 12 - 14 - 16 1700 1700 18 1900 1900 20 2200 - 22 2400 - 24 2600 - 26 2800 -		1100 1300 1500 1700 1900 2200 2400 2600 2800	$T_{jm} = 125^{\circ}\text{C}$ Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный длительностью не более 10 мс, управляющий вывод разомкнут
U_{DWM} U_{RWM}	Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии, рабочее импульсное обратное напряжение, В	0,8 U_{DRM}		$T_{jm} = 125^{\circ}\text{C}$ Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный длительностью не более 10 мс
U_D U_R	Постоянное напряжение в закрытом состоянии, постоянное обратное напряжение, В	0,6 U_{DRM}		$T_c = 85^{\circ}\text{C}$
$(du_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс, не менее, для группы: 4 200 5 320 6 500 7 1000			$T_j = 125^{\circ}\text{C}; \quad U_{DM} = 0,67U_{DRM};$ $t_{u min} = 200 \text{ мкс}$ Цепь управления разомкнута
I_{DRM} I_{RRM}	Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более	3		$T_j = 25^{\circ}\text{C}$
		50		$T_{jm} = 125^{\circ}\text{C};$ $U_D = U_{DRM}; \quad U_R = U_{RRM};$ Цепь управления разомкнута

Параметр		Значение параметра МТ12/3-800 МТД12/3-800 МДТ12/3-800 МТ12/4-800 МТ12/5-800	Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения		
U_{DRM} U_{RRM}	Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов: 6 8 10 12	600 800 1000 1200	$T_{jm} = 125^{\circ}\text{C}$ Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный длительностью не более 10 мс, управляющий вывод разомкнут
U_{DSM} U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов: 6 8 10 12	670 900 1100 1300	$T_{jm} = 125^{\circ}\text{C}$ Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный длительностью не более 10 мс, управляющий вывод разомкнут
U_{DWM} U_{RWM}	Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии, рабочее импульсное обратное напряжение, В	0,8 U_{DRM}	$T_{jm} = 125^{\circ}\text{C}$ Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный длительностью не более 10 мс
U_D U_R	Постоянное напряжение в закрытом состоянии, постоянное обратное напряжение, В	0,6 U_{DRM}	$T_c = 75^{\circ}\text{C}$
$(du_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс, не менее, для группы: 4 5 6 7	200 320 500 1000	$T_j = 125^{\circ}\text{C}; U_{DM} = 0,67U_{DRM}; t_{u min} = 200 \text{ мкс}$ Цепь управления разомкнута
I_{DRM} I_{RRM}	Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более	3	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$
		50	$T_{jm} = 125^{\circ}\text{C}; U_D = U_{DRM}; U_R = U_{RRM};$ Цепь управления разомкнута

Параметры открытого состояния, прямые параметры

Параметр		Значение параметра модуля		Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	MTT12/3-500 МТД12/3-500 МДТ12/3-500 MTT12/4-500 МТД12/4-500 МДТ12/4-500 MTT12/5-500 МТД12/5-500 МДТ12/5-500	MTT12/3-630 МТД12/3-630 МДТ12/3-630 MTT12/4-630 МТД12/4-630 МДТ12/4-630 MTT12/5-630 МТД12/5-630 МДТ12/5-630	
I_{TAVM} I_{FAVM}	Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, максимально допустимый средний прямой ток, А	500	630	$T_c = 85 \text{ }^{\circ}\text{C}$ Импульс тока синусоидальный однополупериодный длительностью не более 10 мс, частотой 50 Гц
	Фактический максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, фактический максимально допустимый средний прямой ток, А	539	635	$T_c = 85 \text{ }^{\circ}\text{C}, T_j = 125 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $U_{T(TO)}, r_T$ при $T_j = 125 \text{ }^{\circ}\text{C}$
I_{TRMS} I_{FRMS}	Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии, максимально допустимый действующий прямой ток, А	785	990	$T_c = 85 \text{ }^{\circ}\text{C}$ Импульс тока синусоидальный однополупериодный длительностью не более 10 мс, частотой 50 Гц
I_{TSM} I_{FSM}	Ударный ток в открытом состоянии, ударный прямой ток, кА	16,5	22	$T_j = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$
		15	20	$T_{jm} = 125 \text{ }^{\circ}\text{C}$ Импульс тока синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью 10 мс, $U_R = 0, I_G = I_{GT}$ при $T_j = -40 \text{ }^{\circ}\text{C}$
U_{TM} U_{FM}	Импульсное напряжение в открытом состоянии, импульсное прямое напряжение, В, не более	1,55	1,45	$T_j = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}; I_T = 3,14I_{TAVM},$ $I_T = 3,14I_{FAVM}$ Длительность одиночного импульса тока не менее 500 мкс
$U_{T(TO)}$ U_{TO}	Пороговое напряжение в открытом состоянии, пороговое напряжение, В	0,83	0,82	$T_{jm} = 125 \text{ }^{\circ}\text{C}$
r_T	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, динамическое сопротивление в прямом направлении, мОм	0,41	0,22	$T_{jm} = 125 \text{ }^{\circ}\text{C}$
I_H	Ток удержания, мА, не более	300		$T_j = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}, U_D = 12 \text{ В}$ Цепь управления разомкнута
I_{TAV} I_{FAV}	Средний ток в открытом состоянии, средний прямой ток (на элемент) при работе одного модуля с охладителем, А	190	208	$T_a = 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$, естественное охлаждение, охладитель OP564-300

Параметр		Значение параметра МТТ12/3-800 МТД12/3-800 МДТ12/3-800 МТТ12/4-800 МТТ12/5-800	Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения		
I_{TAVM} I_{FAVM}	Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, максимально допустимый средний прямой ток, А	800	$T_c = 75^\circ\text{C}$ Импульс тока синусоидальный однополупериодный длительностью не более 10 мс, частотой 50 Гц
	Фактический максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, фактический максимально допустимый средний прямой ток, А	801	$T_c = 75^\circ\text{C}, T_j = 125^\circ\text{C}$ $U_{T(TO)}, r_T$ при $T_j = 125^\circ\text{C}$
I_{TRMS} I_{FRMS}	Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии, максимально допустимый действующий прямой ток, А	1260	$T_c = 75^\circ\text{C}$ Импульс тока синусоидальный однополупериодный длительностью не более 10 мс, частотой 50 Гц
I_{TSM} I_{FSM}	Ударный ток в открытом состоянии, ударный прямой ток, кА	22	$T_j = 25^\circ\text{C}$
		20	$T_{jm} = 125^\circ\text{C}$ Импульс тока синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью 10 мс, $U_R = 0, I_G = I_{GT}$ при $T_j = -40^\circ\text{C}$
U_{TM} U_{FM}	Импульсное напряжение в открытом состоянии, импульсное прямое напряжение, В, не более	1,4	$T_j = 25^\circ\text{C}; I_T = 3,14I_{TAVM},$ Длительность одиночного импульса тока не менее 500 мкс
$U_{T(TO)}$ U_{TO}	Пороговое напряжение в открытом состоянии, пороговое напряжение, В	0,76	$T_{jm} = 125^\circ\text{C}$
r_T	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, динамическое сопротивление в прямом направлении, МОм	0,20	$T_{jm} = 125^\circ\text{C}$
I_H	Ток удержания, мА, не более	300	$T_j = 25^\circ\text{C}, U_D = 12\text{ В}$ Цепь управления разомкнута
I_{TAV} I_{FAV}	Средний ток в открытом состоянии, средний прямой ток (на элемент) при работе одного модуля с охладителем, А	223	$T_a = 40^\circ\text{C}$, естественное охлаждение, охладитель OP564-300

Параметры управления

Параметр		Значение параметра	
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	<i>Условия установления норм на параметры</i>	
U_{GT}	Отпирающее постоянное напряжение управления, В, не более	2,5	$T_j = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}; U_D = 12 \text{ V}$
		3,5	$T_{j\min} = -40 \text{ }^{\circ}\text{C}; U_D = 12 \text{ V}$
I_{GT}	Отпирающий постоянный ток управления, мА, не более	250	$T_j = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}; U_D = 12 \text{ V}$
		350	$T_{j\min} = -40 \text{ }^{\circ}\text{C}; U_D = 12 \text{ V}$
U_{GD}	Неотпирающее постоянное напряжение управления, В, не менее	0,25	$T_{jm} = 125 \text{ }^{\circ}\text{C}; U_D = 0,67 U_{DRM}$ Напряжение источника управления - постоянное

Параметры переключения

Параметр		Значение параметра		Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	MTT12/3-500, МТД12/3-500, МДТ12/3-500, MTT12/4-500, MTT12/5-500	MTT12/3-630, МТД12/3-630, МДТ12/3-630, MTT12/4-630, MTT12/5-630, MTT12/3-800, МТД12/3-800, МДТ12/3-800, MTT12/4-800 MTT12/5-800	
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс	200		$T_{jm} = 125^{\circ}\text{C}$, $U_D = 0,67 U_{DRM}$, $I_T \geq I_{TAVM}$ Импульс тока синусоидальный однополупериодный частотой 50 Гц
		800		$T_{im} = 125^{\circ}\text{C}$, $U_D = 0,67 U_{DRM}$, $I_T = 2I_{TAVM} \div 3I_{TAVM}$ Импульс тока синусоидальный однополупериодный, частотой 1 Гц. Режим цепи управления: форма - трапециевидная; длительность импульса тока (50 ± 5) мкс; амплитуда - $3I_{GT}$ (при температуре перехода минус $(40\pm 3)^{\circ}\text{C}$); длительность фронта не более 1 мкс. Внутреннее сопротивление источника управления (5 ± 1) Ом. Время испытаний не менее 2 мин.
t_q	Время выключения, мкс, не более, для группы: E2 H2 K2 M2	500 400 320 -	500 400 320 250	$T_{jm} = 125^{\circ}\text{C}$; $I_T = I_{TAVM}$; $t_{i min} = 300$ мкс; $(di_T/dt)_f = 5$ А/мкс; $U_R = 100$ В; $U_D = 0,67 U_{DRM}$; $t_{u min} = 200$ мкс; $(du_D/dt)_{crit} = 50$ В/мкс

Тепловые параметры

Параметр		Значение параметра <i>МТТ12/3-500, МТД12/3-500, МДТ12/3-500, МТТ12/4-500, МТТ12/5-500, МТТ12/3-630, МТД12/3-630, МДТ12/3-630, МТТ12/4-630, МТТ12/5-630, МТТ12/3-800, МТД12/3-800, МДТ12/3-800, МТТ12/4-800 МТТ12/5-800</i>	Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения		
T_j	Максимально допустимая температура перехода, $^{\circ}\text{C}$	125	
$T_{j\min}$	Минимально допустимая температура перехода, $^{\circ}\text{C}$	минус 40	
T_{stg_m}	Максимально допустимая температура хранения, $^{\circ}\text{C}$	40	
$T_{stg\min}$	Минимально допустимая температура хранения, $^{\circ}\text{C}$	минус 40	
R_{thjc}	Тепловое сопротивление переход-корпус, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$, не более	0,054	Постоянный ток
R_{thch}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$, не более	0,032	
R_{thja}	Тепловое сопротивление переход-среда (с охладителем), $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$, не более	0,436	$T_a = 40 \ ^{\circ}\text{C}$, естественное охлаждение, охладитель OP564-300

Параметры термодинамической устойчивости

Параметр		Значение параметра <i>МТТ12/3-500, МТД12/3-500, МДТ12/3-500, МТТ12/4-500, МТТ12/5-500, МТТ12/3-630, МТД12/3-630, МДТ12/3-630, МТТ12/4-630, МТТ12/5-630, МТТ12/3-800, МТД12/3-800, МДТ12/3-800, МТТ12/4-800 МТТ12/5-800</i>	Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения		
$I_{c(crit)}$	Ток термодинамической устойчивости корпуса, кА	6,0	$t_i = 10 \text{ мс}$
$I_{c(crit)}^2 \cdot t$	Защитный показатель термодинамической устойчивости корпуса, $\text{A}^2 \cdot \text{с}$	$18 \cdot 10^4$	

Параметры изоляции

Параметр		Класс модуля	Значение параметра			Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения		MTT12/3-500 МТД12/3-500 МДТ12/3-500 МТТ12/4-500 МТТ12/5-500	MTT12/3-630 МТД12/3-630 МДТ12/3-630 МТТ12/4-630 МТТ12/5-630	MTT12/3-800 МТД12/3-800 МДТ12/3-800 МТТ12/4-800 МТТ12/5-800	
U_{isol}	Электрическая прочность изоляции между беспротенциальным основанием модуля и его выводами, В (действующее значение)	6-8	-	-	2000	Нормальные климатические условия. Частота испытательного напряжения 50 Гц, время испытания 1 мин
		10-12	-	-	2500	
		10-16	-	2500	-	
		16	2500	-	-	
		18	-	3600	-	
		18-26	3600	-	-	Повышенная влажность (>80%). Частота испытательного напряжения 50 Гц, время испытания 1 мин.
		6-12	-	-	1500	
		10-18	-	1500	-	
		16-26	1500	-	-	
R_{isol}	Сопротивление изоляции между беспротенциальным основанием модуля и его выводами, МОм, не менее	6-12	-	-	50	Нормальные климатические условия. Напряжение 1000 В, время испытания 10 с
		10-18	-	50	-	
		16-26	50	-	-	
		6-12	-	-	5	Повышенная влажность (>80%). Напряжение 1000 В, время испытания 10 с
		10-18	-	5	-	
		16-26	5	-	-	